

韓国東海カーボンの連結子会社化について

2018年5月14日

東海カーボン株式会社
代表取締役社長 長坂一

案件概要

対象会社	韓国東海カーボン(TCK社)	<当社の持分法適用会社>
株式取得相手先	KC Co., Ltd. (KC社)	<当社に次ぐTCK社の第2位株主>
取得株式数	1,050,750 株	
出資比率	本件前:35.4%→本件後:44.4% (本件後実質基準にて連結子会社化となる見込み)	
取得価額	78億円*	
資金調達手法	手許現預金を予定	

*1KRW0.101円で計算しております

韓国東海カーボン(TCK社)の概要

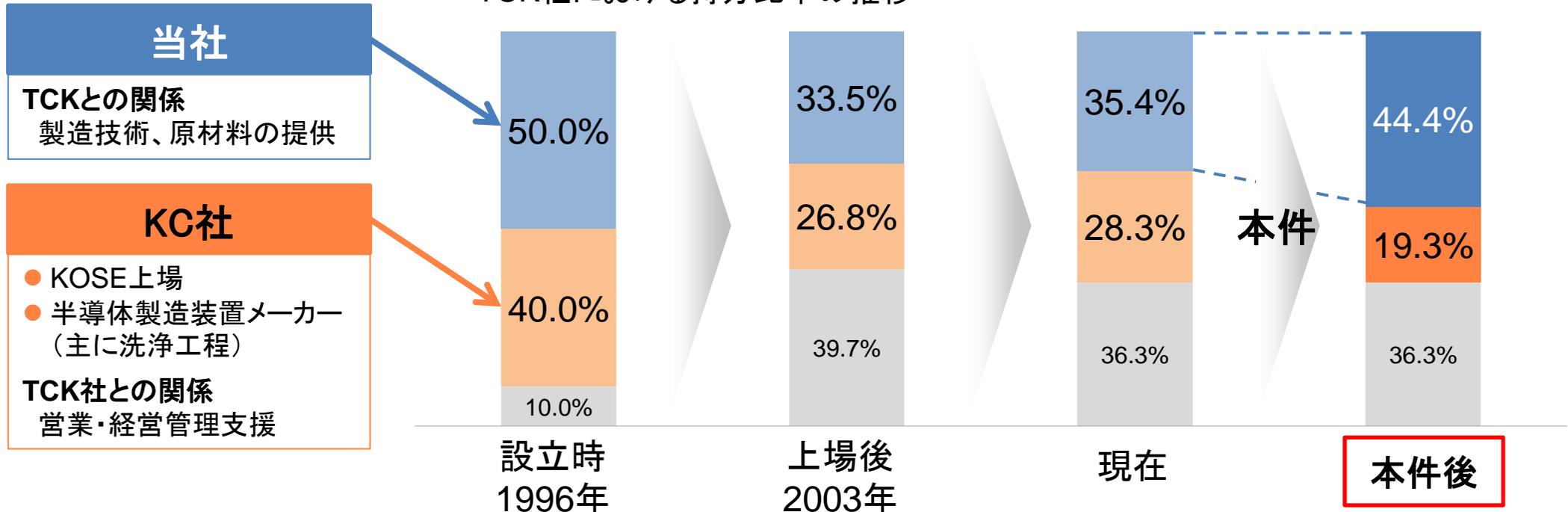
会社名	韓国東海カーボン(Tokai Carbon Korea)
設立年月	1996年8月
時価総額*	7,320億KRW(739億円) / KOSDAQ上場(証券コード:064760)
業績*	2017年12月期: 売上高 1,303 億KRW (132億円) 営業利益 477 億KRW (48億円)
従業員	約320名
事業概要	Solid SiC Focus Ring、SiC Coat製品、特殊炭素製品の製造販売 主な顧客は大手半導体メーカー及び半導体製造装置メーカー

*時価総額及び業績はKRW=0.101円で計算しております。また、時価総額は2018年5月11日時点

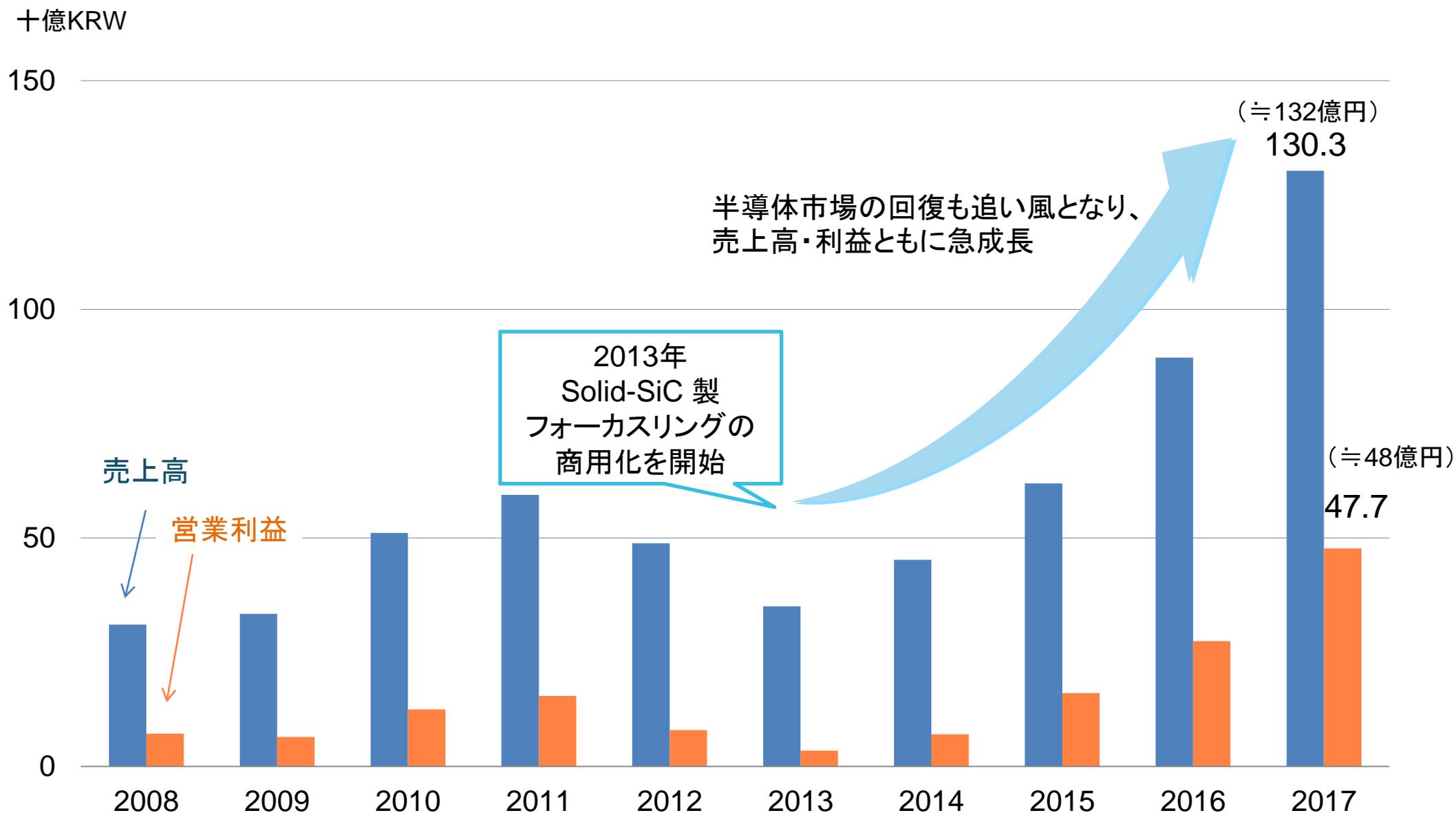
当社・KC社・TCK社の関係

- 当社・KC社を含む3社が合弁会社としてTCK社設立
- KC社とは、TCK社設立以来20年以上にわたり、事業パートナーとして関係を構築
- 当社およびKC社が相互の事業強化(集中と選択)を図るため、本件に至る

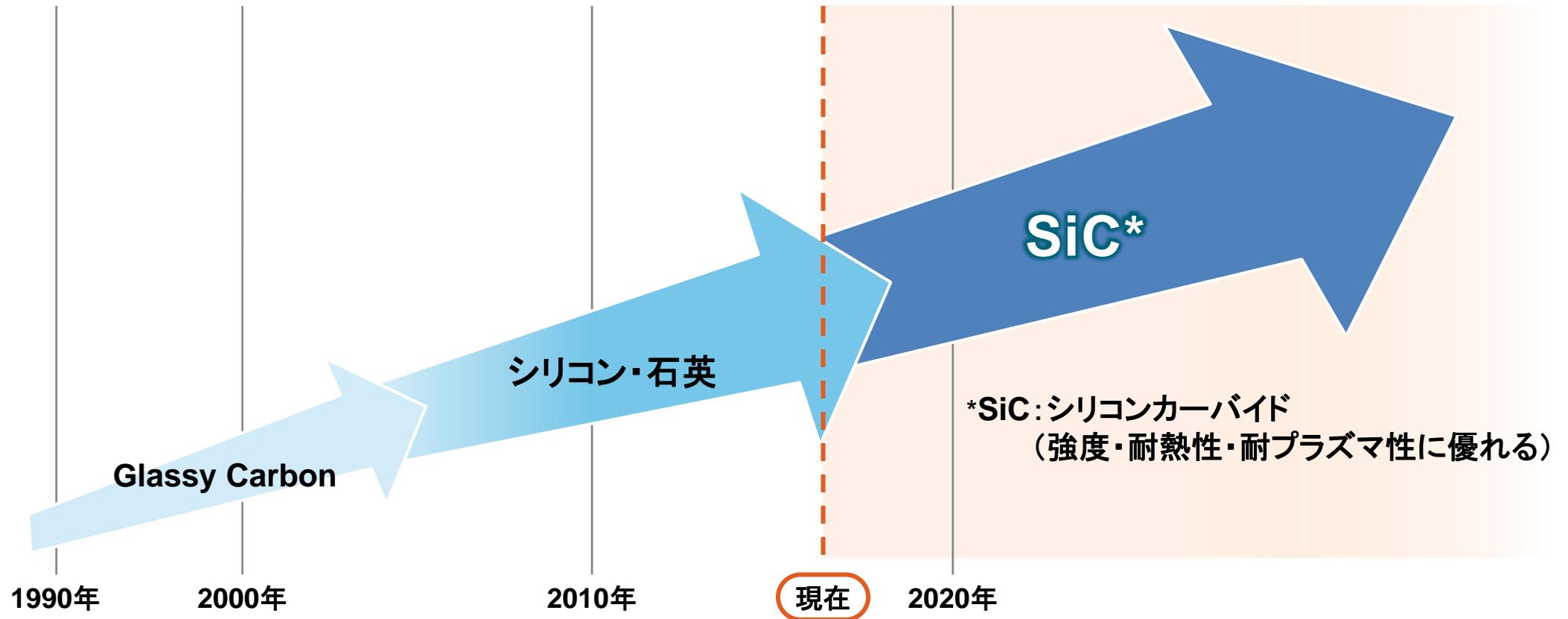
■ TCK社における持分比率の推移



TCK社過去10年の業績推移



フォーカスリング用素材の変遷

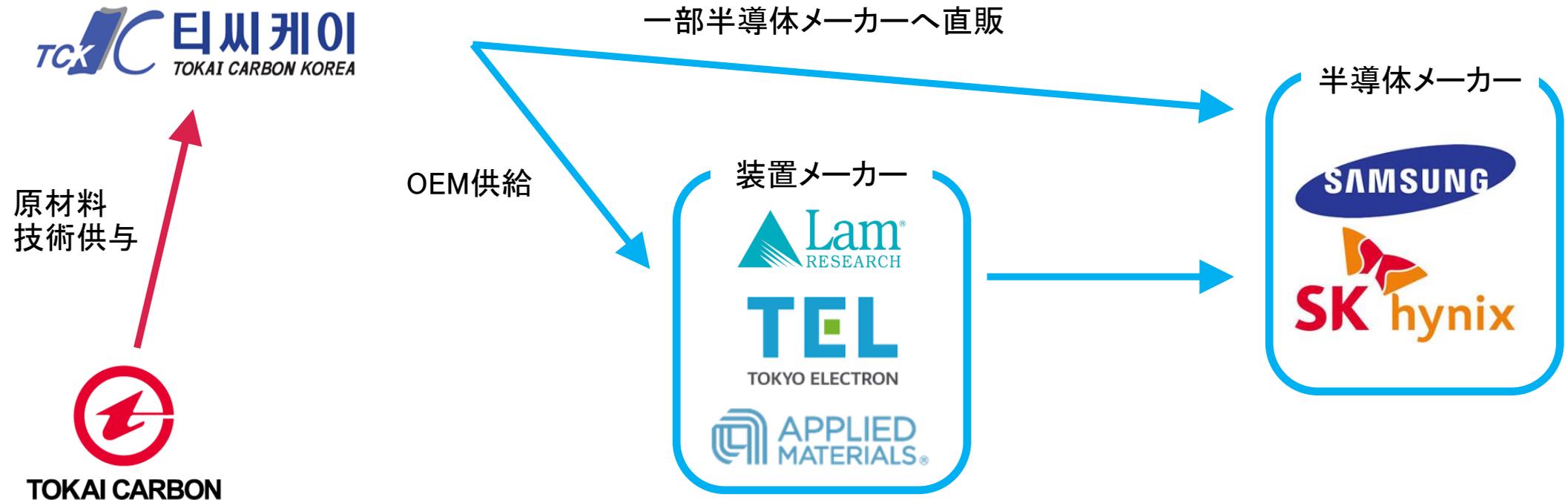


- 半導体の微細化・高集積化に伴い、エッチング回数増加・プラズマ高出力化
- Glassy Carbon、シリコン/石英に次ぐ、第三世代の素材としてCVD*-SiCが開発された
- CVD*-SiC製品はその優れた特性により、半導体メーカーのトータルコスト削減に寄与

*CVD(Cheical Vapor Deposition)技術: 反応管内で加熱した基盤物質の上に、目的とする薄膜の成分を含む原料ガスを供給し、化学反応により膜を堆積する方法

TCK社はCVD-SiC製品のトップランナー

■ TCK社の主要顧客

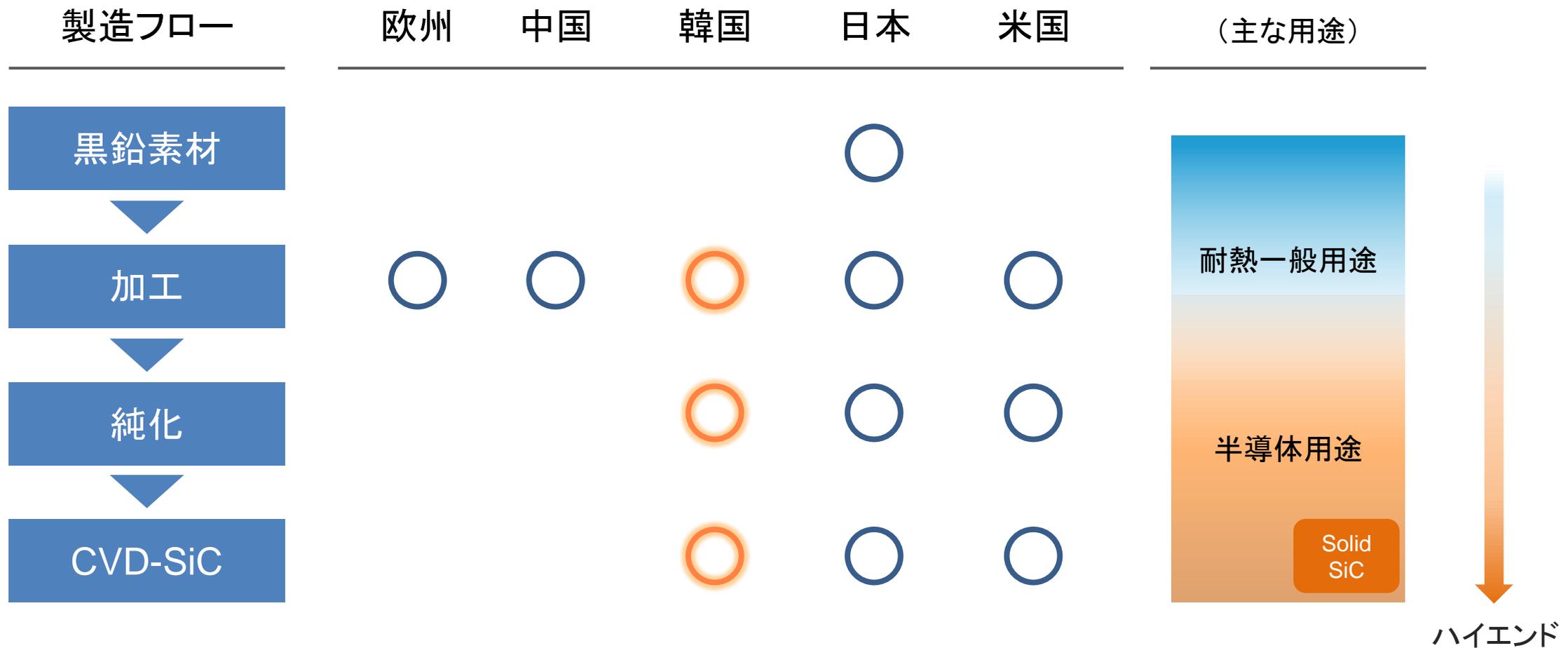


- 主要半導体メーカーとの強固な関係と技術力をベースにビジネスを拡大
- 世界最大規模のCVD-SiC生産及び処理設備保有し、高い市場シェアを誇る
- 主要製品であるSolid SiC製フォーカスリングでは、当社より基本技術を供与。
現在はトップランナーとして圧倒的な存在

ファイナカーボン事業のバリューチェーン強化

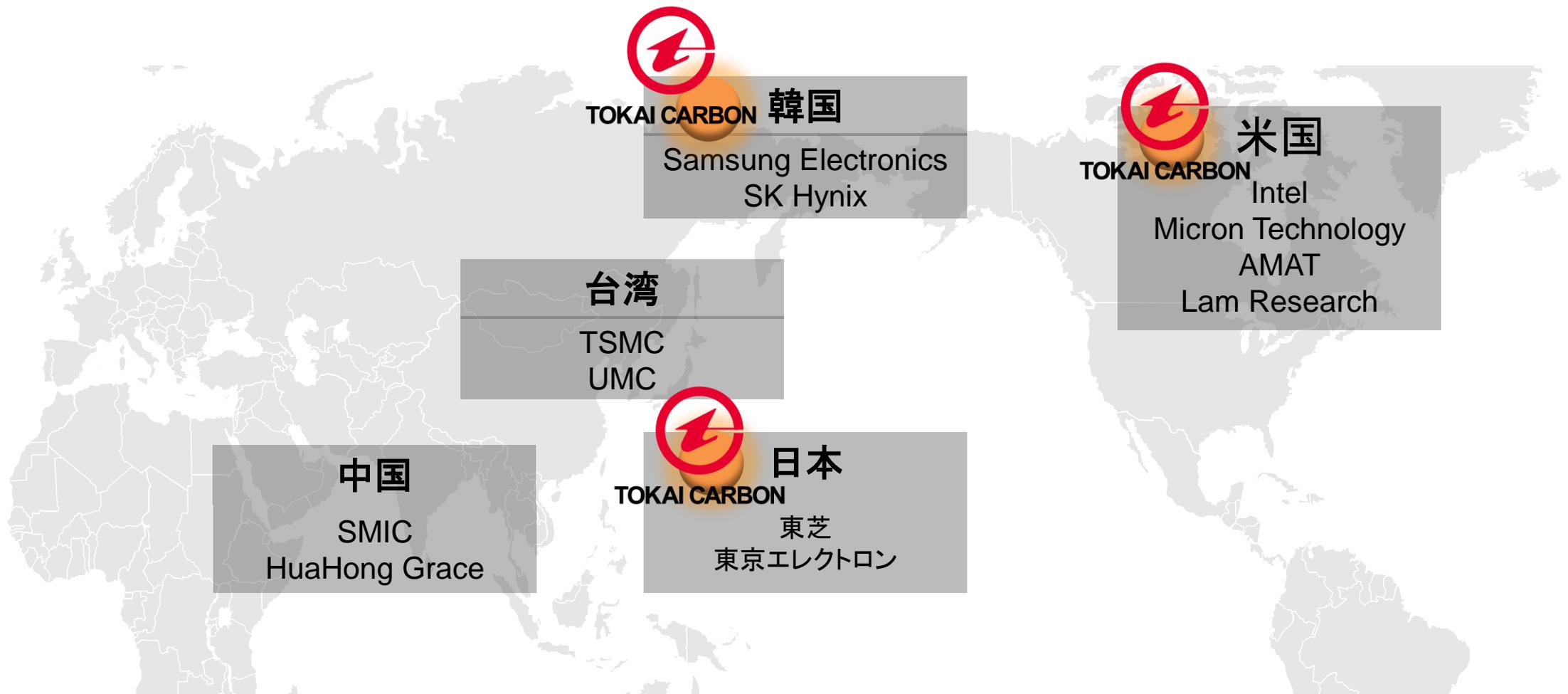
- 半導体等の用途には高純度処理、CVD-SiCコート処理が求められる。韓国拠点獲得により、グループ効率運営を図り、半導体メーカー等のユーザーへのサービス・提案力が向上

(拠点別 保有設備)



半導体関連メーカーの集積地において事業展開

- 日本、米国、韓国、台湾に半導体デバイスメーカー、半導体装置メーカーが集積
- 本件により、日・米・韓の3カ国に加工・純化・CVD拠点を展開する唯一のメーカーへ



今後の展望

- 世界最大規模のCVD-SiCコート生産・処理設備を有するTCK社を連結子会社化することが事業拡大・競争力向上に寄与
- 成長する半導体市場でTCK社と一体となった事業展開を実行し、更なる顧客価値を提供



今後のスケジュール・業績への影響

日程

- 取締役会決議日：2018年5月14日
- 契約締結日：2018年5月14日
- 株式取得完了日：2018年5月下旬見込み
- 本日程は2018年5月14日のものであり、今後契約締結手続きなどにより変更となる可能性があります

業績への影響

- 2018年12月期連結業績に与える影響については、TCK社連結子会社化による売上、利益、資産等の増加が見込まれます。今後精査を行い、業績予想の修正等、開示すべき事項が発生した場合は、速やかに開示いたします

将来の見通しに関する注意事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。

実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、経済情勢、原材料価格、製品の需要動向及び市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

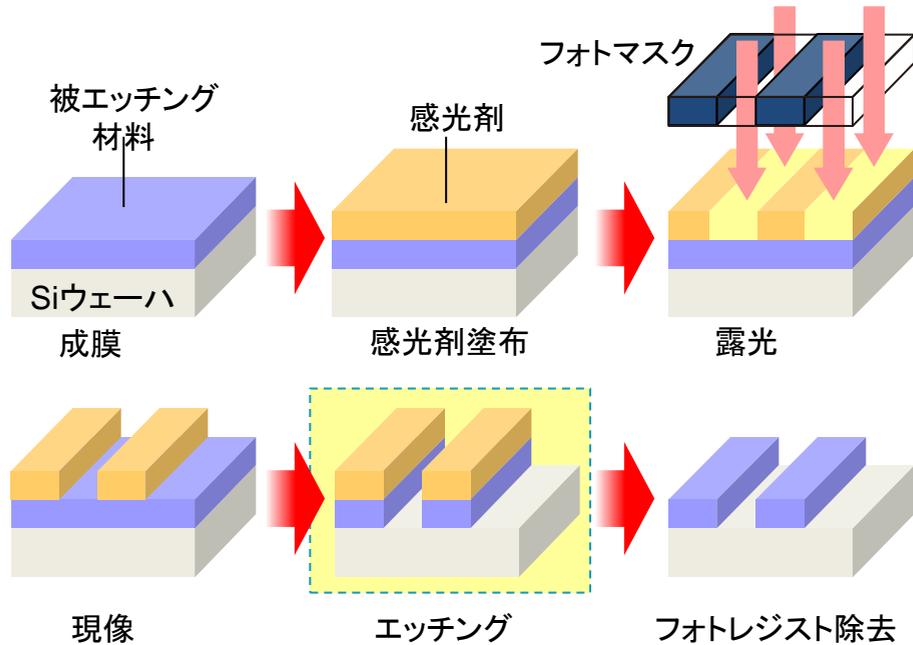
本件に関する連絡先
経営企画室 初鹿野 TEL 03-3746-5228

(ご参考) Solid SiC Focus Ringとは

- Solid-SiCとは：CVD法により製造される超高純度のシリコンカーバイド
- 特徴：強度・耐熱性・耐プラズマ性・耐薬品性に優れる
- その特性から高出力化が進展するエッチング装置の部材（Focus Ringなど）として使用

■ エッチング工程とは

- ✓ 膜を削り取り、半導体の回路を浮き彫りにする工程



■ Solid SiC Focus Ring

